国研で未来を拓くデバイス研究しませんか？

–持続可能で強靭な社会を目指して–　[グリーンICTデバイス研究室]

この挑戦は、根幹となるデバイスと、
それを創る「人」から始まります。
未来を共に拓く仲間を、私たちは探しています。

《公募中ポスト》

公募 No.	職種・人数	主な業務内容	応募要件概要
2027R-10	有期研究員 １名	Ga_2O_3 電子デバイス研究開発 （素子試作、 DC/RF 特性評価等）	博士号取得（見込含）。半導体デバイス分野の専門知識と研究経験
2027T-5	有期研究技術員 各１名	酸化ガリウムデバイスの設計・試作技術に関する研究開発支援	高専・大卒以上。半導体デバイス又は電子材料に関する知識
2027T-6		酸化ガリウムデバイスの測定・評価技術に関する研究開発支援	

《求める人材像》

専門分野が多少異なっても……
強い熱意を持つ方を歓迎します！

詳細・公募要件はQRコードからご確認いただけます。

公募ページ　2027R-10　2027T-5　2027T-6

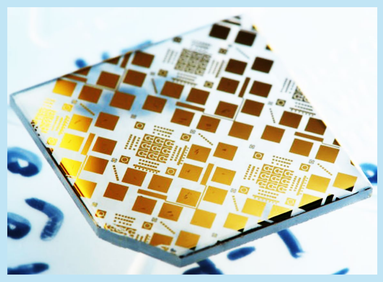
[採用ページ、各ポストのURL]
お問い合わせ: kamimura@nict.go.jp （上村）

Our Research

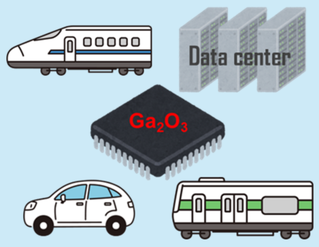
【酸化ガリウムが拓く、次世代デバイスの可能性】

《省エネルギー社会の鍵となる「パワーデバイス」》

既存の限界を超え、パワーユニットの革新を通じて社会全体の省エネルギー化に貢献します。



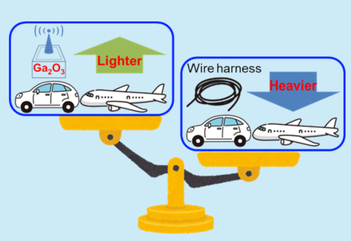
酸化ガリウム基板上に作製した
電子デバイス (10 × 10 mm)



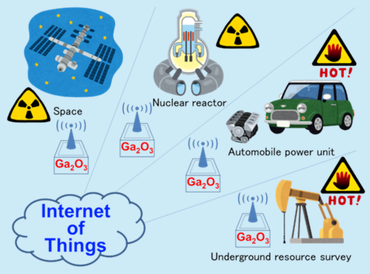
パワーユニットの省エネ化へ貢献

《社会基盤を支える「極限環境 通信デバイス」》

宇宙や放射線下など極限環境で真価を発揮し、未来の IoT 社会の通信基盤を構築します。



ワイヤーハーネスフリー化による軽量化



半導体デバイス未踏の極限環境下で
IoT 実現による作業の高効率化

私たちは、世界で初めて「酸化ガリウムが SiC や GaN を超える次世代パワーデバイス材料である」ことを実証・発信してきました。その実績を礎に、現在この2つの柱で研究を推進しています。

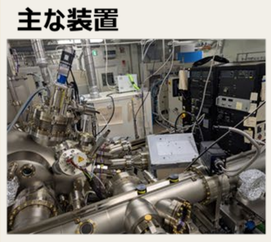
Why NICT?

【世界レベルの研究を支える環境】

《最先端の研究設備》

国内有数の設備群を駆使して、自身のアイデアを迅速に検証・実現できる環境です。

主な装置



分子線エピタキシー装置
（エピタキシャル膜成膜）



反応性イオンエッチング装置
（エッチングプロセス）



電子線描画装置
（デバイスパターン作製）

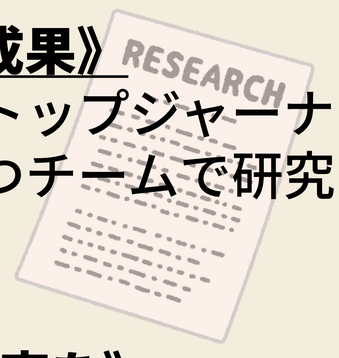


半導体パラメータアナライザ
（電気伝導特性評価）

結晶成長、微細なデバイス作製、特性評価 ⇒ 一貫して実施可能

《世界的に評価される研究成果》

応用物理学会優秀論文賞をはじめ、トップジャーナル掲載など、世界レベルの実績を持つチームで研究に挑戦できます。



《多様な仲間と、主体的な研究を》

様々な国籍の研究者が在籍。若手が主体となって国の重要課題に挑戦でき、将来に繋がる専門性と人的ネットワークを築けます。





公募期間についてのご案内

本ポスターをご覧いただき、ありがとうございます。

情報通信研究機構（NICT）の有期研究員・有期研究技術員の公募は、一定期間ごとに公募を行う形式を取っています。

そのため、学会開催期間中や直後に、公募期間が一時的に終了している場合があります。

現在、公募ページに募集が掲載されていない場合でも、ご関心を持っていただいた時点で、あきらめる必要はありません。

次回の公募は、準備が整い次第、改めて開始予定です。

次回公募までの間に、

- 研究内容について簡単に知りたい
- 自分の専門が合うか確認したい
- 応募時期の目安を知りたい

といった点があれば、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ先：

国立研究開発法人 情報通信研究機構
小金井フロンティア研究センター グリーンICTデバイス研究室
E-mail: Kamimura@nict.go.jp
上村 崇史

※応募を前提としないお問い合わせでも、お気軽にご連絡ください。